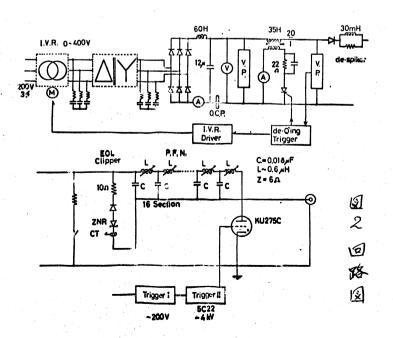
## フォトンファクトリー入射器用

クライストロン・モジュレータ電源

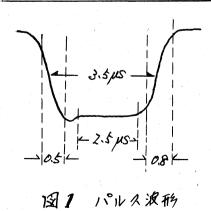
高工名儿书一研 福田茂樹, 沪見昌三, 設樂哲夫, 田中治郎 日本原子力研究所 益子勝夫

放射光入射器の30MWクライストロンモジュレータの鍼作機は、砂年3月末に東芝によって10KV近のパルステストを行って、納入された。その後255KVクルパワーテスト、de-Qing 回路テスト、安定性、今後の改良点と量産に向けての検討等を進めて来た。以下それらの概要について述べる。 表1

表1KJOMWクライストロンモジュレータの仕様 及びパル久波的について示す。又図みは本電源の回路図機略を示す。本電源の特長としては電源の昇降 はIVRで行われるが、これはde-Qing回路と連動している事である。IVRコントローラの切換えにより任意のde-Qing量がかけられるが通常は自動を一下によりde-Qing量がからられるから、制御されている。de-Qing 回路は安定度を得るなめに必要である。を配子ョーりは十分検討して設計された。フ次側人ンダクタンスは17%となっている。



八心人以为特性	
兴颐出力能力	84 MW
平均出力電力	14.7KW
出力電圧範囲	0-23KV
出力電流	3650A max
受行んとーダンス	6.30
出カインピーダンス	6.00
パル久幅	2.3 USWI
立上り時間	O.SUSWF
11年11時間	0. Pusur
緑返し	sopps
パルグ平担度	0.1% W.F
ハルス守定度(短時間)	0.2%以下
(長時間)	0.5% WF/R



PFN回路は16段で猶成され、PFNコンデンサ 一はリードインダクタン久を極力ふさくすねため 両端が電極であり、硬子を用いない型にした。 又パル久平担度の調整は高圧印加時でも出来るよ うKPFNコイルは可変は構造となっている。 サイクトロンはITT社KU275Cを用いなが アノード運延時間及びジッターを経れ小とくするため K、そのしりがー(トリガーI)は最大4kPの八。 ル久を用いた。契測の結果にりが一種圧は又KT へ名KDで、ジッター等大差はなかっな。同じ目的で 補助電極にはキーパアライが電圧とプレトリガー もかけている。負荷の短絡時以サイラトロンハ 過火連電圧がかかねのを防ぐ保護回路としては EOL クリッパーガ式を採用した。国子は関荷を ミスマツムさせな時の巨の人回路を流れる電流であ る。EOL抵抗は電力容量の点から若干高インド ーダンスにしているので、J回程の反射をくり返 して減煮しているのがわかる。EOL回路は現在 負荷の異常的以正常に動作している。

パルス回路で生す方連い成分を防ぐデスパイカー 回路も又正常に動作している。図がはデスパイカー回路の前後での電圧波形であるが、約3 MS程度のスパイクが吸収されている。

本間源のクルパワーテストは最初担抗負荷で 近った。パルス平担後はPFNの調整でのよる追 達成したが、負荷抵抗の温度保教 か、かのの抵抗 を公本使用したための浮遊谷量等に帰因すると思わ、

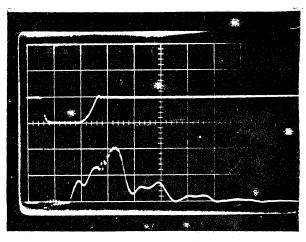
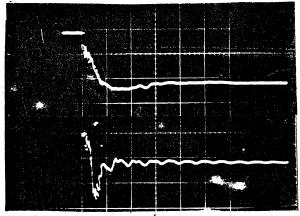
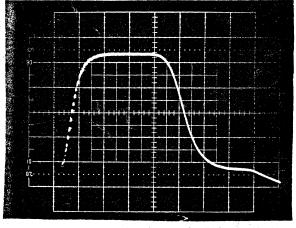


図3,上:パルス変形,下:クリッパー電流機軸:Zus/diu,微軸;arbitary, g行ふらの



国文, デスパリカー前後の電圧液形上; 倉電回路側, 下; 夜電回路側, 下; 夜電回路側, \$US/div



図が 成りパレス液形, 270KT 1 μs/dù (ハリストランス = 次側液形)

れる問題が置じた。国かはPFN回路も改善した彼の、クライストロン負荷時のパルス液形であり、文次側で最大270KD、パルス平程度は粗調整のみであるがの、3分以下と存っている。

パルス安定度は重要な問題であるので特に良 く鯛べた。旅々のテクトしな環境は悪く、陽子シ ンケロトロンの至リングの影響で常時、電源変動 が3分以上ある. そのなめde-Qing 回路が安定 K働く事が絶対の条件である。充電トランスのL ヒPFNコンデンサーから決まる危電時間は lons である。PFNにかかる電圧を為圧1°4-1°(2000 : 1)で分圧し、de-Qingトリが-回路で基準電 圧と比較しSCRヘaトリが-を発生している。 為圧パロールは立上りsons以下、又トリガー回路 も女上りやジッター等十分検討を加え、固定遅延時 聞は 1 US以下である。de-Q'ing回路のRBUC を変えde-Qingのされがどうなるか、又次のサイ クル近de-Qing 電流が流れたらどうなるか、安 花度がどうなるか等調べた。最初はSLACの計 質式11に続ってR= 2211, C=70PFであったが Cを省略した場合、R=12An場合ともに安定度に は大差がなかった。安定度は短時間で容易にの1% 以不が達成できた。図6はR=12の時のde-Qing on-解時內充電電在波形,因了1日二次側を流れる de-Qing 電流波形である。図813 de-Qing 1-11 h"-に同期×火た時のPFNにかかる電圧(de-Qing on との引してある。高圧パローハッの帯域調整の問題も 含めて、トリかー国路からSCR点弧近 Sus程度 に国定時間進れを抑えている。

以上の結果、ほぼ社嫌を満足する結果を得ている。分後は量産に何けて、価格の歴滅化、機構の簡素化、制御系等の改良等を目標としている。

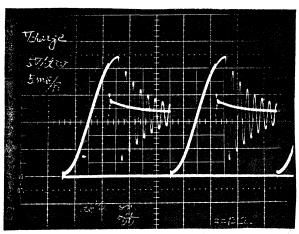


図6 de-Qing ON, OFF 時の充電電圧 R=120, CBU, 5ms/div

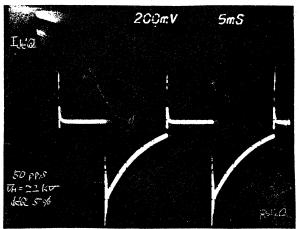


图7 de-Qing 二次侧面流浪形

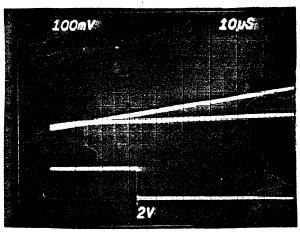


图8 上: PFN便压(de-Q'off) 中: " (de-Q'on) 下: de-Q'nig |-11 1 "一信号

\* (1) The Stanford Two-Mile Accelerator, edited by R.B. Neal, Chap. 13.